



一种三维环栅半导体场效应晶体管的制备方法

专利名称: 一种三维环栅半导体场效应晶体管的制备方法
专利类别: 发明
申请号: 2016111135213
第一发明人: 顾长志
其它发明人: 郝婷婷;李无瑕;李俊杰
专利授权日期: 2020-06-19

[关闭窗口](#)

